

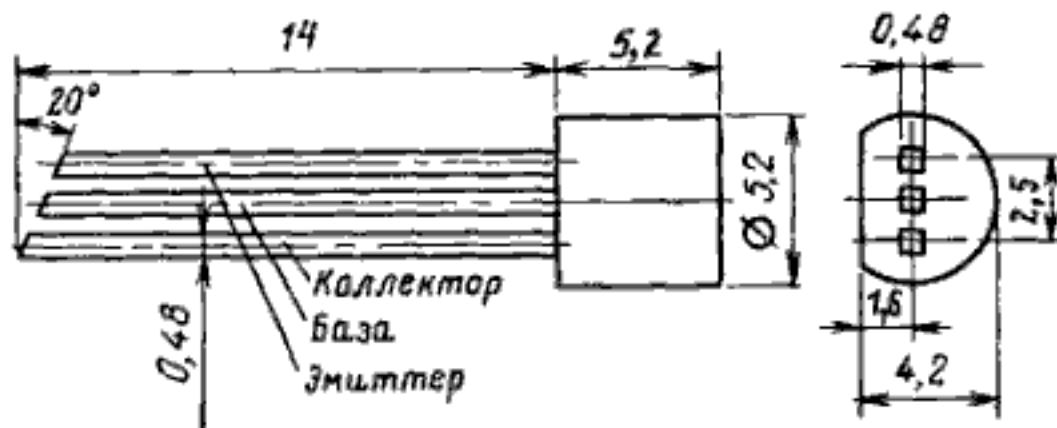
КТ503А, КТ503Б, КТ503В, КТ503Г, КТ503Д, КТ503Е

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* универсальные низкочастотные маломощные.

Предназначены для работы в усилителях НЧ, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных схемах.

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на этикетке.

Масса транзистора не более 0,3 г.



Электрические параметры

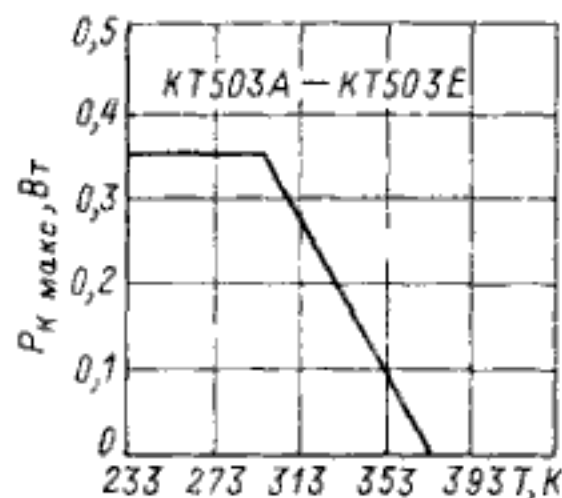
Граничное напряжение при $I_3 = 10$ мА, $\tau_{и} \leq 30$ мкс, скважности > 100 не менее	
КТ503А, КТ503Б	25 В
КТ503В, КТ503Г	40 В
КТ503Д	60 В
КТ503Е	80 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА не более	0,6 В
типовое значение	0,2* В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА не более	1,2 В
типовое значение	0,8* В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_3 = 10$ мА	
КТ503А, КТ503В, КТ503Д, КТ503Е	40 — 120
КТ503Б, КТ503Г	80 — 240
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_3 = 3$ мА не менее	5 МГц
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В, $f = 465$ кГц не более	20 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = U_{КБ \text{ макс}}$ не более	1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

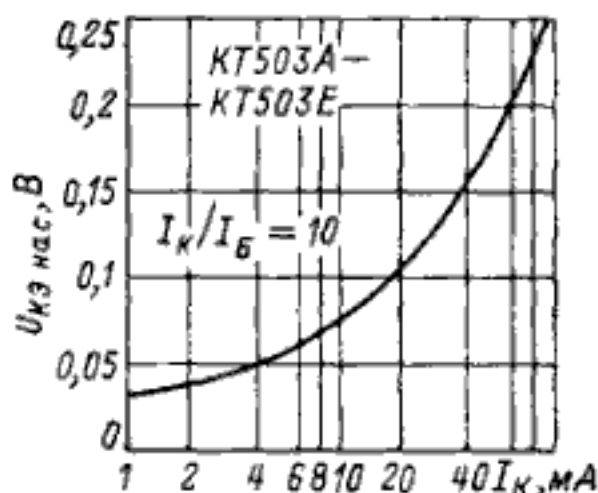
Постоянное напряжение коллектор-база	
КТ503А, КТ503Б	40 В
КТ503В, КТ503Г	60 В
КТ503Д	80 В
КТ503Е	100 В
Постоянное напряжение база-эмиттер	5 В
Постоянный ток коллектора	0,15 А
Импульсный ток коллектора при $\tau_n \leq 10$ мкс, $Q \geq 100$	0,35 А
Постоянный ток базы	0,1 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = 233 - 298$ К	0,35 Вт
Температура перехода	398 К
Температура окружающей среды	От 233 до 358 К

Примечание Пайку выводов разрешается производить на расстоянии не менее 5 мм от корпуса. При пайке жало паяльника должно быть заземлено. Разрешается производить пайку путем погружения выводов не более чем на 3 с в расплавленный припой с температурой не выше 523 К.

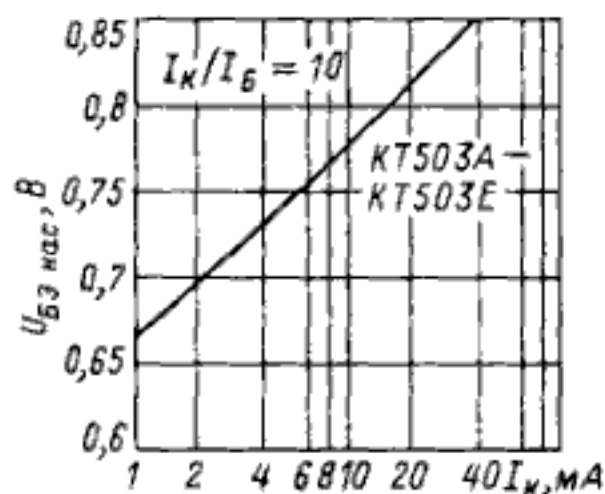
Изгиб выводов допускается производить на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5–2 мм, при этом должны приниматься меры, исключающие передачу усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.



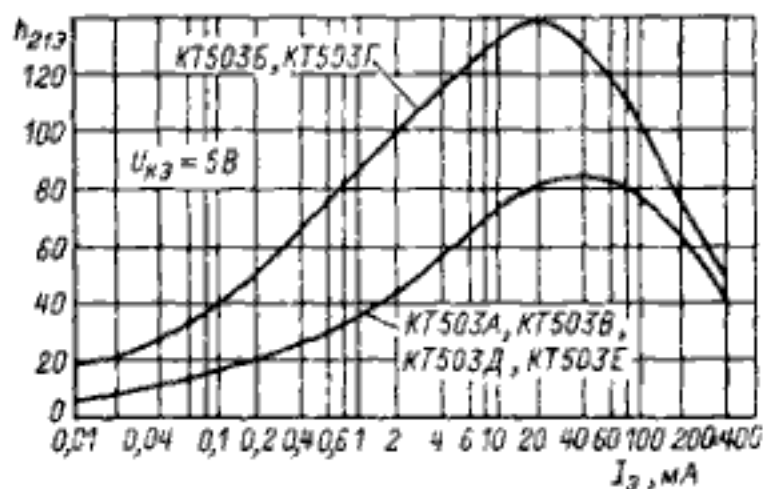
Зависимость максимально допустимой постоянной мощности рассеивания коллектора от температуры



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера